

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

| Обозначение | Термины |
|--------------------|--|
| V_{RRM} | Повторяющееся импульсное обратное напряжение |
| V_{DRM} | Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии |
| V_{TM} | Импульсное напряжение в открытом состоянии |
| $V_{T(TO)}$ | Пороговое напряжение тиристора |
| V_{GT} | Отпирающее постоянное напряжение управления |
| V_{GTM} | Отпирающее импульсное напряжение управления |
| I_{RRM} | Повторяющийся импульсный обратный ток |
| I_{DRM} | Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии |
| I_{TM} | Импульсный ток в открытом состоянии |
| $I_{T(AV)}$ | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии |
| I_{TRMS} | Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии |
| I_{TSM} | Ударный ток в открытом состоянии |
| i^2t | Защитный показатель (значение интеграла от квадрата ударного неповторяющегося тока в открытом состоянии тиристора за время протекания) |
| I_{GT} | Отпирающий постоянный ток управления |
| I_{GTM} | Отпирающий импульсный ток управления |
| T_c | Температура корпуса |
| T_{jmax} | Максимально допустимая температура перехода |
| r_T | Динамическое сопротивление |
| P_{RSM} | Ударная обратная рассеиваемая мощность |
| t_{gt} | Время включения (для тиристорov) |
| t_q | Время выключения (для тиристорov) |
| $(dv_D/dt)_{crit}$ | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии |
| $(dv_D/dt)_{com}$ | Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения |
| $(di_T/dt)_{crit}$ | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии |
| $R_{th(l-c)}$ | Тепловое сопротивление переход-корпус |
| M_d | Крутящий момент |
| F | Усилие сжатия |
| V_{isol} | Напряжение пробоя изоляции между выводами и основанием (эффективное значение) |
| V_{MG} | Электрическая прочность изоляции между силовой и управляющей цепями |
| w | Масса |